

SiC(0001)上のSi₂N₃表面ハニカム格子

安藤, 寛

<https://hdl.handle.net/2324/4060154>

出版情報 : Kyushu University, 2019, 博士 (工学), 課程博士
バージョン :
権利関係 :

氏 名	安藤 寛				
論 文 名	SiC(0001)上の Si ₂ N ₃ 表面ハニカム格子				
論文調査委員	主 査	九州大学	職名	教授	氏名 田中 悟
	副 査	九州大学	職名	教授	氏名 村上 恭和
	副 査	九州大学	職名	教授	氏名 水野 清義

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、2次元ハニカム物質形成のためのテンプレートとして、ハニカム表面構造を有する Si₂N₃/SiC(0001)を提案し、計算および実験からその有用性を示したものである。特に汎用の半導体基板である SiC 上に 2次元ハニカム物質が形成可能であることを示したことは次世代デバイス応用上有益な結果であると考えられ、応用物理学上寄与するところが大きい。よって本論文は博士（工学）の学位論文に値すると認める。